2SA985,985A/2SC2275,2275A

PNP/NPNエピタキシアル形 シリコントランジスタ 低周波電力増幅用，高周波電力増幅用

PNP/NPN Silicon Epitaxial Transistor
Audio Frequency Power Amplifier,
High Frequency Power Amplifier

特長／FEATURES

○実効出力60～120 W用パワーアンプのドライバ段として最適。
○高耐圧であり，かつ f_T が高い。
○h_{FE}，f_T の大電流の伸びが良い。

外形図／PACKAGE DIMENSIONS

(Unit : mm)

電極接続
1. Base
2. Collector (Fin)
3. Emitter
4. Fin

絶対最大定格／ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T_a = 25 °C)

項目	略号	2SA985/2SA985A	2SC2275/2SC2275A	単位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	−120/−150	120/150	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	−120/−150	120/150	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	−5.0	5.0	V
コレクタ電流(直流)	$I_{C(DC)}$	−1.5	1.5	A
コレクタ電流(パルス)	$I_{C(pulse)}$ *	−3.0	3.0	A
ベース電流(直流)	$I_{B(DC)}$	−0.3	0.3	A
全損失	$P_{T(T_C=25\,°C)}$	25	25	W
全損失	$P_{T(T_a=25\,°C)}$	1.5	1.5	W
ジャンクション温度	T_j	150	150	℃
保存温度	T_{stg}	−55～+150	−55～+150	℃

* PW≦10 ms, duty cycle≦50 %

電気的特性／ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_a = 25 °C)

2SA985, 2SA985A/2SC2275, 2SC2275A

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	V_{CB} = −120/120 V, I_E = 0			−1.0/1.0	μA
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	V_{EB} = −3.0/3.0 V, I_C = 0			−1.0/1.0	μA
直流電流増幅率	h_{FE1}	V_{CE} = −5.0/5.0 V, I_C = −5.0/5.0 mA *	35	160/130		
直流電流増幅率	h_{FE2}	V_{CE} = −5.0/5.0 V, I_C = −0.3/0.3 A *	60	150	320	
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	I_C = −1.0/1.0 A, I_B = −0.1/0.1 A *		−0.3/0.2	−2.0/2.0	V
ベース飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	I_C = −1.0/1.0 A, I_B = −0.1/0.1 A *		−0.9/0.9	−1.5/1.5	V
利得帯域幅積	f_T	V_{CE} = −5.0/5.0 V, I_C = −0.2/0.2 A		180/200		MHz
コレクタ容量	C_{ob}	V_{CB} = −10/10 V, I_E = 0, f = 1.0 MHz		29/19		pF

* Pulse Test/PW≦350 μs, duty cycle≦2 %
h_{FE}区分(h_{FE2})/R：60～120 Q：100～200 P：160～320

EEPW 电子产品世界 .com.cn